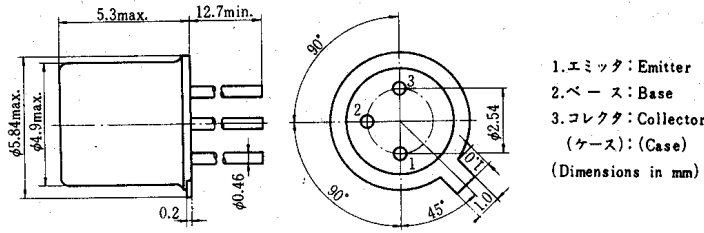


# 2SC1706(H)

シリコン NPN 三重拡散形  
高電圧スイッチング用

SILICON NPN TRIPLE DIFFUSED  
HIGH VOLTAGE SWITCHING



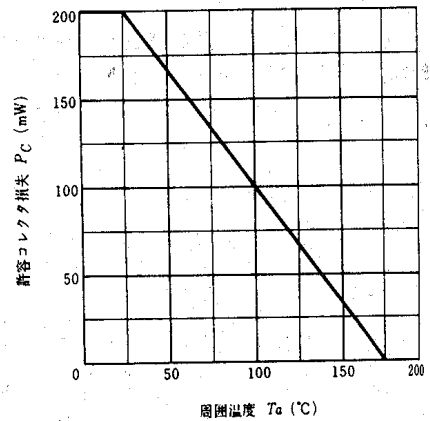
1.エミッタ: Emitter  
2.ベース: Base  
3.コレクタ: Collector  
(ケース): (Case)  
(Dimensions in mm)

(JEDEC TO-18)

## ■ 絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

項	目	Symbol	2SC1706(H)	Unit
コレクタ・ベース電圧	$V_{CBO}$		200	V
コレクタ・エミッタ電圧	$V_{CES}$		200	V
	$V_{CEO}$		150	V
エミッタ・ベース電圧	$V_{EBO}$		5	V
コレクタ電流	$I_C$		50	mA
許容コレクタ損失	$P_C$		200	mW
接合部温度	$T_j$		175	$^\circ\text{C}$
保存温度	$T_{stg}$		-65~+175	$^\circ\text{C}$

## 許容コレクタ損失の周囲温度による変化 MAXIMUM COLLECTOR DISSIPATION CURVE



## ■ 電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

項	目	Symbol	Test Condition	min	typ	max	Unit
コレクタ・エミッタ破壊電圧	$V_{(BR)CES}$		$I_C=10\mu\text{A}, R_{BE}=0$	200	—	—	V
	$V_{(BR)CEO}$		$I_C=1\text{mA}, R_{BE}=\infty$	150	—	—	V
エミッタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)EBO}$		$I_E=10\mu\text{A}, I_C=0$	5	—	—	V
コレクタ遮断電流	$I_{CBO}$		$V_{CB}=100\text{V}, I_E=0$	—	—	0.1	$\mu\text{A}$
直流電流増幅率	$h_{FE}$		$V_{CE}=6\text{V}, I_C=10\text{mA}$	30	—	300	
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$		$I_C=10\text{mA}, I_B=1\text{mA}$	—	—	1.0	V
ベース・エミッタ飽和電圧	$V_{BE(sat)}$			—	—	1.5	V
高周波電流増幅率	$h_{fe}$		$V_{CE}=6\text{V}, I_C=10\text{mA}, f=20\text{MHz}$	3	—	—	
コレクタ出力容量	$C_{ob}$		$V_{CB}=6\text{V}, I_E=0, f=1\text{MHz}$	—	—	10	pF
ターンオン時間	$t_{on}$		$I_C=10\text{mA}, I_{B1}=-10\text{mA}, I_{B2}=10\text{mA}$	—	150	—	ns
ターンオフ時間	$t_{off}$			—	1.5	—	$\mu\text{s}$
蓄積時間	$t_{stg}$		$I_C=I_{B1}=-I_{B2}=20\text{mA}$	—	2.0	—	$\mu\text{s}$